

Технологическая модернизация и перспективы развития ОАО «НИИПП» <i>Пономарев А.А., Яук Э.Ф.</i>	31
Прямое сопротивление потерь в СВЧ рiп-диодах на арсениде галлия <i>Айзенштат Г.И., Юценко А.Ю., Божков В.Г., Безрук А.В.</i>	45
Влияние облучения быстрыми нейтронами на надежность элементов систем оптико-электронного наблюдения <i>Градобоев А.В., Салчак Я.А.</i>	56
Результаты ОАО «НИИПП» в области разработки GaAs СВЧ МИС на основе рiп-диодов <i>Юценко А.Ю., Айзенштат Г.И., Монастырев Е.А., Божков В.Г., Иващенко А.И., Безрук А.В.</i>	65
Оптоэлектроника и 50 лет НИИПП <i>Вилшов А.А.</i>	76
Импульсные быстровосстанавливающиеся диоды ОАО «НИИПП» <i>Малаховский О.Ю., Фотина Л.В.</i>	93
Органическая электроника в Томске <i>Копылова Т.Н., Гадиров Р.М., Никонова Е.П., Тельминов Е.Н., Дегтяренко К.М.</i>	96
Физико-химические основы формирования поверхности полупроводников типа АШВУ в жидкой среде <i>Мокроусов Г.М., Бекезина Т.П., Зарубина О.Н., Куйдина Г.Ю.</i>	100
Электронные свойства структур на основе арсенида галлия, компенсированного примесями с глубокими уровнями <i>Толбанов О.П.</i>	108

Экономика

Теоретические основы и инструментарий оценки эффективности разработки новых технологий <i>Авдоини Б.Н., Батьковский А.М., Батьковский М.А., Кравчук П.В.</i>	123
Принципы внедрения системы контроллинга на предприятиях радиоэлектронной промышленности и инструментарий их реализации <i>Боков С.И.</i>	141